

Султанов Азрет Оюсович

**Закономерности роста эпитаксиальных пленок β -SiC на кремнии с нанопористым
буферным слоем и исследование их физических свойств**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Специальность **01.04.10 – Физика полупроводников**

Работа выполнена на кафедре «Физика конденсированных сред» Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор кафедры «Физика конденсированных сред» Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, Сафаралиев Гаджимет Керимович.

Научный консультант: к.ф.-м.н., заместитель директора Института функциональной ядерной электроники НИЯУ МИФИ Гусев Александр Сергеевич

Экспертная комиссия:

1. Костишин Владимир Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Ховайло Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, НИТУ «МИСиС»;
3. Мурашев Виктор Николаевич, доктор технических наук, профессор, кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников, НИТУ «МИСиС»;
4. Тимошенко Виктор Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор, кафедра физики низких температур и сверхпроводимости, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
5. Лебедев Александр Александрович, доктор физико-математических наук, руководитель отделения твердотельной электроники Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

Ведущее предприятие:

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Защита диссертации состоится «26» ноября 2019 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 4